FILED 4/30/03

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-324276

(43)公開日 平成4年(1992)11月13日

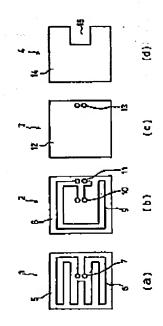
(51) Int.Cl.5	敝別配与	庁内整理番号	F 1	1	支術表示循所
H05B 3/20	393	7913-3K			
C 0 4 B 35/58	104 Y	8821-4G			
H05B 3/14	В	8715-3K			
H05K 1/03	• н	7011-4E		•	
1/09	В	8727—4E	ş	務査請求 未請求 簡求項の数	4(全 5 頁)
(21) 出願番号	特顏平3-94355		(71)出版人	000001258 川崎聚鉄株式会社	·
(22) 出願日 平成 3 年 (1991) 4 月 24日			兵成県神戸市中央区北本町通 号	1丁目1番28	
			(72)発明者	字田川 悦郎	
`				千葉市川崎町1番地 川崎製 術研究本部内	法株式会社技
,			(72)発明者	村 直美	
				千葉市川崎町 1 番地 川崎縣 術研究本部内	铁株式会社技
			(74)代理人	护理士 小杉 佳男 (外1 :	名〉
* . *					
					最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 A1Nセラミツクヒータ及びその製造方法

(57) 【契約】

[目的] AIN基板を積層して発熱抵抗体を内装させたセラミックヒータの基体内の温度分布の均一化を図る。また電極部を外部へ取出す方法として、ビアホールを利用し、電極部と外部配額とのろう付け部に切欠を設けることによって、電極部が突出しない、両面が平坦なセラミックヒータを製造する。

【構成】第1層基板1はセラミック基板5の上面全面に 発熱抵抗体6、端子7を有する。第2層基板2はセラミック基板8の上面の周縁部に発熱抵抗体9を有する。第 3層基板3はセラミック基板12に上下貫道ビアホール 18を有する。第4層基板4は切欠15を有する第1層 基板1の端子7は、第2層基板2のビアホール10対向 する位置に殴けられている。第2層基板2の端子11 は、第3層基板3のビアホール13に対向する位置に設 けられている。第4層基板4の切欠15は第3層基板3 のビアホール13に対向する位置に設けられている。



(2)

特開平4-324276

【特許商求の顧問】

基板の上面に発熱抵抗体を設け、その上 【財求項1】 にピアホール電極を有する基板及び該電極部に対応する 切欠を有する最上層基板を積層してなることを特徴とす るAINセラミックヒータ。

【請求項2】 上面に発熱抵抗体を設けた基板が複数の 租屋体であり、該基板上の発熟抵抗体を結合する導通ビ アホールを育することを特徴とする関求項1記載のA1 Nセラミックヒータ。

【闡求項3】 基板が熱伝導率160W/m・K以上の 10 AIN寅焼豬体であり、発熱抵抗体がW-AINの複合 焼結体からなり10-1Ω・cm以下の室温時の低気抵抗 率及び正の抵抗温度係数を有することを特徴とする隣求 項1又は2配戦のAINセラミックヒータ。

【関求項4】 厚膜印刷法によって発熱抵抗体を形成 し、該発熱抵抗体をグリーンシート積層法によりセラミ ック基体中に埋設することを特徴とする請求項1、2又 は3記載のAINセラミックヒータの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、家庭用機器、電子機 器、産業用機器、及び自動車等に利用されるセラミック ヒータ及びその製造方法に関する。

[0002]

[従来の技術] これまでにセラミックスを基体とするヒ **一夕としては、W(タングステン)ーアルミナ系、ある** いはMo (モリブデン) -アルミナ系において実用化が 図られており、多くの製品がでている。このようなアル ミナ系におけるセラミックヒータは基体が電気的、化学 的に安定であるばかりでなく、発熱抵抗体の電気的特 性、熟的特性に関して設計上に多くの利点を有する。

【0003】しかし、アルミナは熟趣張が大きく、熱伝 **導が悪いことから念滋な温度変化に弱く、耐熱衝撃温度** が150~250℃と低い。さらに、熱伝導性に劣るこ とから、プレート状の基体の場合には、通電時に発熱部 とプレート周辺部の温度差が大きくなりやすく、被加熱 物に対する熱伝達効率が低いといった問題がある。ま た、家庭用機器、電子機器、産業用機器及び自動車用と 広く用いられいているセラミックヒーター般に対し、

- (1) 設定の退度への到達時間の短縮
- 熱サイクル及び電圧印加サイクルにおける、電 気的、機械的信頼性の向上
- 熱伝遊効率の向上 (3)
- (4) 使用環境に対する耐性の向上

などの要求が高まってきている。このような要求に対 し、アルミナを基体とした既存のセラミックヒータでは 十分に応えられなくなっている。

【0004】そこで、従来のアルミナに代る基体とし て、窓化アルミニウム(AIN)又は窒化ケイ素などの に使るだけでなく、特に、AINは熱膨張が小さい上 に、熱伝導率がアルミナの10倍程度もあることなどか. ら、新しいセラミックヒータ用の基体として有望視され ている。

【0005】しかし、A1Nはアルミナと比べ単身でも 焼結が難しく、発熱抵抗体を内蔵したものはいまだに実 現していない。これはAINの焼成が一般には1800 で以上という高温でなされることと、脱脂及び窒素不雰 囲気でなされることが原因で、AINと同時に焼成でき る材料が限られているためである。これまでに、AIN と同時に焼成できる材料としてWやMoをはじめとする 高融点金属を用いた開発が進められてきたが、AINと の焼結性の一致をはかりながら所望の物性値を得ること が困難であった。

【0006】また、発熱抵抗体のバターンをセラミック 焼結体内に形成する方法も、単純なものに限られてお り、このためプレート状の基体表面での温度分布が不均 ・一となったりする場合が多い。

[00073

【発明が解決しようとする課題】本発明は、従来からあ るセラミックシートの積層技術と厚膜印刷技術、さらに。 はスルーホールメタライズ技術を用いて、発熱抵抗体を 内職したセラミックヒータを開発するにあたり、プレー ト状の基体内の温度分布の均一化を図ることを目的とす る。また電板部を外部へ取出す方法として、ビアホール を利用する技術、さらには電板部と二クロム線等の外部 配線との基体中におけるろう付け部に切欠を設けること によって、電極部が交出しない、すなわち両面が平坦な セラミックヒータを製造する技術を提供する。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明は、基板の上面に 発熱抵抗体を設け、その上にピアホール電極を有する基 板及び眩電極部に対応する切欠を有する最上層基板を積 用してなることを特徴とするAINセラミックヒータで ある。この場合、上記上面に発熱抵抗体を取けた基板を 複数の積層体とし、これらの基板上の発熱抵抗体を導通 ピアホールで結合すると好適である。

【0009】また、本発明のAINセラミックヒータは その好ましい突施態様として、基板が熱伝導率160W /m・K以上のA I N質焼結体であり、発熱抵抗体はW -AlNの複合機結体からなり整温時の電気低効率が1 0°0 C ・ C m以下でかつ抵抗温度係数が正であるセラミ ックヒータを提供する。また、上記のようなセラミック ヒータの製造方法としては、厚膜印刷法によって発熱抵 抗体を形成し、グリーンシート秩層法によって発熱抵抗 体をセラミック基体中に埋設する。

[0010]

【作用】本発明は、AINを基体としたセラミックヒー タであって、内藻された発熱抵抗体として、W、Wの臓 セラミックスが注目されている。これらは機械的な強度 50 化物、あるいはWの酸化物からの変成物よりなる少なく

とも1種類以上の主成分と、基体となるAINとの複合 焼剤体を用いる。本発明はこのような場合のセラミック ヒータ基体の構造及び発熱抵抗体のパターンの配列、並 びに電極の外部への取り出し構造を改善したものであ る。

【0011】本発明は次の作用を生じる。

- (1) ヒータパターンを積層し、3次元配線とすることによって、熱密度を向上させる。
- (2) 基体内の温度分布が均一化する。
- (3) 積層方向の導通はピアホールを用いることによ 10 って、端子を基体外部へ露出させない。

【0012】(4) 最上層基板は切欠を設けた構造により、立体的な基体とし、外部電極部の突出部をなくし、両面が平坦となるようにする。

[0018]

【実施例】図1、図2に、本発明の疾施例の設明図を示した。実施例は4層積層体である。第1層基板1はセラミック基板5の上面全面に発熱抵抗体6、端子7を有する。第2層基板2はセラミック基板3はセラミック基板3はセラミック基板3はセラミック基板3はセラミック基板3はセラミック基板4は9欠15を有する。第3層基板1の端子7は、第2層基板2のピアホール10対向する位置に設けられている。第2層基板2の端子11は、第3層基板3のピアホール13に対向する位置に設けられている。第4層基板4の切欠15は第3層基板3のピアホール13に対向する位置に設けられている。第4層基板4の切欠15は第3層基板3のピアホール13に対向する位置に設けられている。第4層基板4の切欠15は第3層基板3のピアホール13に対向する位置に設けられている。

【0014】次に実施例の製造方法を説明する。平均粒径1、2μmのA1N粉末(酸素含有量0、65重量%、カーボン含有量0、02重量%)に、平均粒径0、5μmのY。O。を2、5重量%を添加し、ポリビニルブチラール(PVB)を適量加えA1Nスラリーとした。このスラリーより、ドクタープレード法にて厚き約1mmのグリーンシートを成形し、さらに65×65mm角に打ち抜き加工した。

[0015] 外形加工の後、図1に示すように、グリーンシートのピアホール10、13の位置にスルーホールを形成し、さらに切欠15を打ち抜いた。引き続き、W粉末(平均粒径1、3μm)、WO 粉末(10μm)を重量比で3:1となるように配合したのちシートと同じA1N粉末を体積比で1:1となるように加え、エタノールを溶媒として用い、アルミナボールによる湿式のミリングを12時間行った。引き続き有機結合剤としてPMMA(ポリメチル・メタ・アクリレート)と、酢酸ブチルを適量加え12時間のミリングを行った後、テレビネオールを適量加えて粘度を調整し、三本ロールミルを通し、印刷用ベーストとした。

【0016】このペーストをA1Nグリーンシート上に スクリーンマスクを用い厚さ約15μmのヒータバター ン(図1に示す発熱抵抗体6、9)を形成した。またス 50 ルーホール10、13にも同様にペーストを充填した。 乾燥後、荷重400kg/cm²、温度130℃で図2 に示すように、積層した。ついで、1,6tのCIP (冷間等方プレス)をかけた。

【0017】 積層体を湿潤水索(N2 -8%H1) 雰囲気で、600℃、8時間の脱脂を行った。引き焼き、窒素雰囲気中で1840℃、6時間の焼成を行い図3に示す焼結体20を得た。ビアホール13の露出部にNi-Bメッキを施して電極としニクロム線16をろう付けした。焼結体20は、基板1~4の積陶体である。同種の積層体をアルミナを基板として製造し、比較例とした。

【0018】 実施例及び比較例について通電試験(約5 **秒で800℃となるように100℃を印加)を行い、ブ** レート状基体の温度分布をサーモビューアにより観察し た。100 V印加1秒後の温度分布及び5秒後の定常状 態における観察結果を図4~図7に示した。図4は実施 例の上面、図5は実施例の下面を示し、それぞれ100 V印加1秒後 (a) に示すように、200℃のリング状 の領域21と、250℃のコア領域22が観察され、5 秒後には(b)に示すように800℃の一様な加熱城2 3が観察された。図6は比較例の上面、図7比較例の下。 面を示し、それぞれ100V印加1秒後(a)に示すよ うに、150℃の領域24とB状の領域25とを生じ、 5秒後に(b)に示すように800℃の定常状態におい ても700℃の周縁領域26、760℃の中央領域2 7、800℃の電極辺傍領域28を生じ、一様な加熱状 餓とならなかった。

[0019]

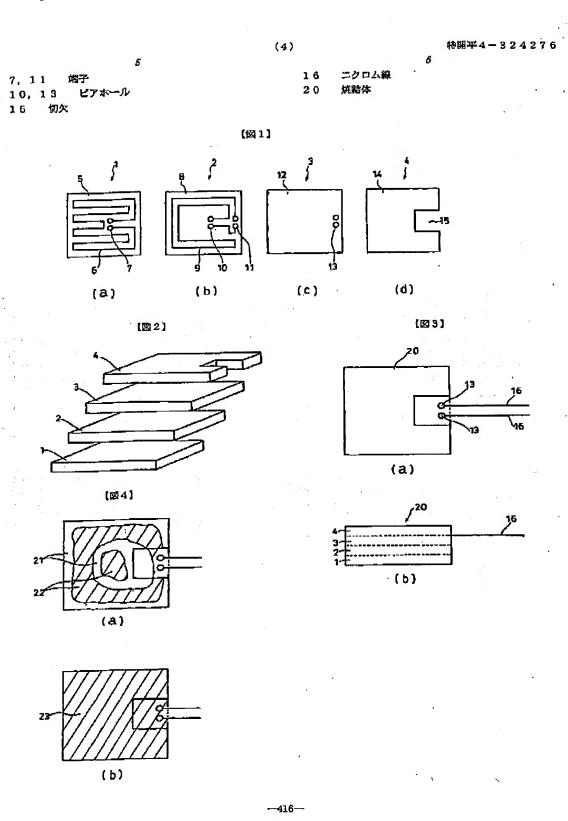
【究明の効果】以上に述べたように本発明によると、基 体にAINを用い、プレート内の温度分布の均一性が著 しく向上したセラミックヒータを実現することができる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】突施例の4枚の恐板の平面図である。
- 【図2】 実施例のセラミックヒータの積層構造を示す斜 視図である。
- 【図3】実施例のセラミックスヒータの(a)平面図、
- (b) 側面図である。
- (図4) サーモビュアによる実施例の観察面の説明図である。
- 【図 5】 サーモビュアによる実施例の観察面の説明図である。
- ・ 【図 6】 サーモビュアによる比較例の観察菌の説明図で ***
- 【図7】サーモビュアによる比較例の観察面の説明図である。

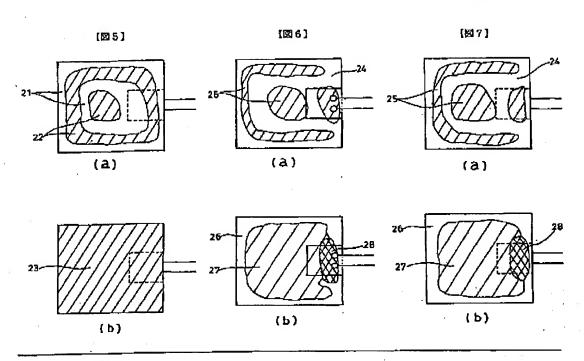
【符号の説明】

- 1, 2, 9, 4 基板
- 5, 8, 12, 14 セラミック基板
- 6,9 発熱抵抗体



(5)

特別平4-324276



フロントページの続き

(72)発明者 前田 粲造

千葉市川崎町1番地 川崎堅鉄株式会社技

術研究本部内

(72) 発明者 能谷 正人

千葉市川崎町1番地 川崎製鉄株式会社技

術研究本部内

AIN CERAMIC HEATER AND MANUFACTURE THEREOF

Patent Number:

JP4324276

Publication date:

1992-11-13

Inventor(s):

UDAGAWA ETSURO; others: 03

Applicant(s):

KAWASAKI STEEL CORP

WANYOUNG LEFT COL

Application

JP19910094355 19910424

Priority Number(s):

IPC Classification:

H05B3/20; C04B35/58; H05B3/14; H05K1/03;

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To manufacture a ceramic heater of which both surfaces are flat and without protruding an electrode part by contriving uniformity of temperature distribution in a base unit of the ceramic heater, internally furnished with a heating resistor by laminating an AIN substrate, utilizing bear holes as a method of taking out the electrode part to the outside and providing a notch in a brazing part of the electrode part to an external wiring.

CONSTITUTION: The first layer substrate 1 has a heating resistor 6 and a terminal 7 in an upper total surface of a ceramic substrate 5. In the second layer substrate 2 has a heating resistor 9 in a peripheral edge part in an upper surface of a ceramic substrate 8. The third layer substrate 3 has vertical through viaholes 13 in a ceramic substrate 12. In the fourth layer substrate 4, the terminal 7 of the first layer substrate 1, having a notch 15, is provided in a position opposed to a beer hole 10 of the second layer substrate 2. A terminal 11 of the second layer substrate 2 is provided in a position opposed to the viahole 13 of the third layer substrate 3. The notch 15 of the fourth layer substrate 4 is provided in a position opposed to the viahole 13 of the third layer substrate 3.

Data supplied from the esp@cenet database - I2